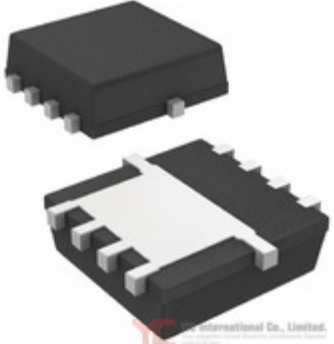


	<h2 style="color: red;">SI7107DN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7107DN-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  SI7107DN-T1-GE3.pdf
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 2584 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

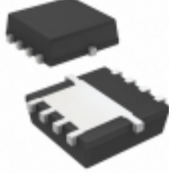
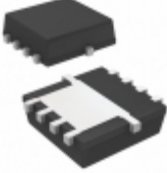

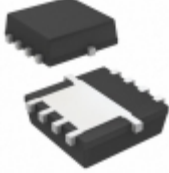


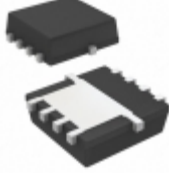
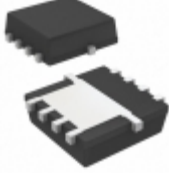
### Spezifikationen

Teilenummer	SI7107DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2584 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 450µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.8 mOhm @ 15.3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7107DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 9.8A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.8A (Ta)

SI7107DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7107DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7107DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7107DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7108DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8</p>	 <p><b>SI7107DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8</p>	 <p><b>SI7108DN</b> VISHAY SI7108DN VISHAY</p>	 <p><b>SI7108DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8</p>
 <p><b>SI7108</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SI7106JN-T1-GE3</b> VISHAY SI7106JN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7107DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8</p>	 <p><b>SI7106DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8</p>

### SI7107DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7107DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7107DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7107DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7107DN-T1-GE3
SI7107DN-T1-GE3 Electronic	SI7107DN-T1-GE3-Komponenten	SI7107DN-T1-GE3-Verteiler	SI7107DN-T1-GE3-Bild	SI7107DN-T1-GE3-Teil
SI7107DN-T1-GE3 Preis	SI7107DN-T1-GE3 Hersteller	SI7107DN-T1-GE3 Bild	SI7107DN-T1-GE3 Aktie	SI7107DN-T1-GE3 Inventar
SI7107DN-T1-GE3 Neu	SI7107DN-T1-GE3 Original	SI7107DN-T1-GE3 garantiert	SI7107DN-T1-GE3 RFQ	SI7107DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited